

# “凝聚态物理-北京大学周二论坛”

2007-12

时间： 2007年6月12日(星期二)下午 15:00 - 16:40

地点： 北京大学物理大楼中 212 教室

报告题目： Quality improvement of III-nitride epilayers and their heterostructures grown on vicinal substrates by rf-MBE

报告人： 沈旭强 主任研究员

报告人简介： 1964年7月出生，1987年毕业于南京大学物理系晶体专业，1995年在日本东京大学电子工程系获博士学位。1995年到2002年间先后在日本东京大学、理化学研究所和电子技术综合研究所工作。2002年起任日本产业技术综合研究所(AIST)任主任研究员。

主要从事化合物半导体材料(GaAs、GaN)的生长、评价及器件研究，在分子束外延(MBE)生长过程中的生长动力学，薄膜与纳米材料(量子点/量子线等)的制作，高质量宽禁带半导体薄膜及异质结结构及其电学性质等方面做过系统的工作。共发表SCI论文80余篇，被引用500多次。

研究方向： 宽禁带半导体材料生长和电子器件研制

联系教授： 沈波教授

联系方式： 电话：62767809， bshen@pku.edu.cn